

智慧財產法院行政判決

109年度行專訴字第25號

原告 宇瞻科技股份有限公司

代表人 陳益世（董事長）

訴訟代理人 李秋成專利師

樓

輔佐人 林克仲

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）住同上

訴訟代理人 陳聖

參加人 田志偉

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國109年3月31日經訴字第10906302100號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項

按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段、第386條分別定有明文。本件參加人受合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，有本院送達證書附卷可稽（見本院卷第387頁），核無民

事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一
造辯論而為判決。

貳、實體事項

一、事實概要：

原告前於民國105 年5 月24日以「抗硫化之記憶體儲存裝置」向被告申請發明專利，申請專利範圍共9 項，經被告編為第000000000 號審查，准予專利，並發給發明第I598878 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於107 年11月14日以該專利違反核准時專利法第22條第2 項之規定，對之提起舉發。原告旋於108 年5 月22日提出系爭專利申請專利範圍更正本。經被告審查，以108 年11月26日（108 ）智專三（二）04169 字第10821118760 號專利舉發審定書為「108 年5月22日之更正事項，准予更正」、「請求項1 至9 舉發成立，應予撤銷」之處分。原告不服前揭處分中有關舉發成立之部分，提起訴願，經經濟部以109 年3 月31日經訴字第10906302100 號決定駁回，原告即向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認原處分與訴願決定不利於原告之部分應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張略以：

（一）系爭專利請求項1 至9具進步性：

證據1 至3 均未揭露系爭專利之請求項1 所界定之抗硫化之記憶體儲存裝置，包括印刷電路板，一抗硫化電阻及一抗硫化排阻，且該抗硫化電阻及該抗硫化排阻彼此間係分離設置，組合證據1 至3 亦無法達到如系爭專利之記憶體儲存裝置抗硫化及增加壽命的效果。證據1 所應用技術之物為排阻，

01 電路板僅為載體，證據2 應用技術之物為載板之保護層，證
02 據3 應用技術之物為電阻器，電路板僅為載體，顯見上開證
03 據所應用之物、原理、機制或作用皆有所差異，其技術領域
04 不具關聯性。證據1 通篇未揭示記憶體儲存裝置面臨環境中
05 濕氣與硫分子硫化的問題，是證據1 至3 所欲解決之問題不
06 具共通性。證據1 的具多電阻值之排組是作為組裝信號的連
07 接或切斷裝置之功能，證據2 的保護塗層僅塗覆至基板之目
08 標區域，以避免保護塗層可能造成的負面影響，證據3 的電
09 阻器是作為過電流保護作用，因此上開證據的功能與作用都
10 不相同，且上開證據也沒有結合的教示或建議，因此所屬技
11 術領域中具有通常知識者在面對記憶體裝置因其被動元件含
12 有銀成分而面臨嚴重的硫化/ 受潮問題導致減少使用壽命時
13 ，無合理動機結合證據1 至證據3 ，而獲得系爭專利請求項
14 1 之發明。又系爭專利請求項2 至5 限定抗硫化電阻之最佳
15 電阻值區間、請求項6 及7 分別限定抗硫化排組之最低電阻
16 值及最高電阻值，證據1 至3 均未記載上開技術特徵，因此
17 證據1 至3 之組合不足以證明系爭專利請求項1 至9 不具進
18 步性。又系爭專利「具有無法預期之功效」、「解決長期存
19 在的問題」及「獲得商業上成功」，具有肯定進步性之輔助
20 性判斷因素。

21 (二)並聲明求為判決：訴願決定及原處分有關「請求項1 至9 舉
22 發成立，應予撤銷」部分均撤銷。

23 三、被告答辯略以：

24 (一)證據1 至3 技術內容都與印刷電路板相關，均屬電子電路技
25 術領域。證據1 有無法對抗環境中濕氣或硫分子的問題，證
26 據2 、3 提供對抗環境中濕氣或硫分子的問題之解決，三者

在解決問題、功能、作用上均有共通性，所屬領域中具有通常知識者站在證據1 的技術基礎上，必定面對嚴重的電阻器與排阻器元件受潮/ 硫化問題，便有動機去參酌同為電子電路技術領域之證據2 所揭示之抗水氣保護塗層，運用於證據1 所揭示之印刷電路板表面，同時再參酌同為電子電路技術領域之證據3 所揭示之使用抗硫化結構電阻元件，替換證據1 所揭示之電阻元件，解決證據1 的被動元件受潮/ 硫化問題，而輕易完成系爭專利請求項1 之發明。

(二)系爭專利說明書並未記載其所揭露記憶體儲存裝置之使用領域為工控領域，且原告也未說明為何以系爭專利請求項2 至9 界定之電阻值有助於增加記憶體於環境之使用壽命，且增加使用壽命的原因在於電阻本身結構上的改良，而非電阻值的選用，原告稱系爭專利請求項2 至9 具進步性並不足採。

(三)並聲明求為判決：駁回原告之訴。

四、參加人未於言詞辯論期日到場，惟據其提出之書狀略以：

抗硫化電阻、排組及保護膜技術早已廣泛應用於各種印刷電路板及電子產品的解決方案，且在證據2 、3 早已揭示，而電阻及排阻本來就是應用在各種印刷電路板及電子產品的元件，組合上開技術並不困難，故證據1 至3 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

五、本院得心證之理由：

(一)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為現行專利法第71條第3 項本文所明定，其立法理由載稱：「核准發明專利權之要件係依核准審定時之規定辦理，其有無得提起舉發之情事，自應依審定時之規定辦理，始為一致，爰予明定。」查系爭專利申請日為105 年5 月24日，

01 經被告審查後於106 年6 月26日准予專利等情，有系爭專利
02 之專利申請書及專利檢索畫面附卷可參（見申請卷第9 、31
03 頁），是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時之106
04 年1 月18日修正公布、同年5 月1 日施行之專利法為斷。次
05 按利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用者，
06 得依法申請取得發明專利，核准時專利法第21條、第22條第
07 1 項前段定有明文，但發明如為「其所屬技術領域中具有通
08 常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得取
09 得發明專利，同法第22條第2 項亦有規定。是本件爭點為：
10 證據1 、2 、3 之組合是否足以證明系爭專利請求項1 至9
11 不具進步性？

12 (二)系爭專利之內容（如附圖一所示）：

13 1.所欲解決之問題及功效（見本院卷第261 至262 頁）：

14 由於目前電子裝置的普及化，其設置之地點極有可能是位於
15 戶外之場所，使得空氣中之化合物或是水分子接觸到記憶體
16 裝置之機率大增，而造成記憶體裝置的壽命減短。舉例來說
17 ，目前記憶體裝置上的電阻均含有銀之成份，當其與空氣中的
18 的硫分子接觸到時，則原有含銀之傳導層將會起化學作用而
19 產生硫化銀，使得此傳導層漸漸成為一絕緣體，而最後將導
20 致電流無法通過此電阻並使此記憶體裝置無法再被使用。又
21 或者，當空氣中的水汽過多時，也可能造成記憶體裝置上的
22 被動元件受潮而無法使用。本發明係提供一種抗硫化之記憶
23 體儲存裝置，其包含一連接介面單元、複數個揮發性記憶體
24 單元以及一印刷電路板。連接介面單元可用以耦接至一主機
25 系統。印刷電路板可包含複數個抗硫化被動元件以及一保護
26 膜，複數個抗硫化被動元件可用以控制並傳導一電流至複數

個揮發性記憶體單元，保護膜可用以覆蓋印刷電路板，其中複數個抗硫化被動元件可包含一抗硫化電阻及一抗硫化排阻。

2.原處分就系爭專利108 年5 月22日更正事項准予更正，當事人未聲明不服，是本件應以更正後之內容為審理，其內容如下：

(1)一種抗硫化之記憶體儲存裝置，包含：

一連接介面單元，用以耦接至一主機系統，

複數個揮發性記憶體單元；以及

一印刷電路板，包含複數個抗硫化被動元件以及一保護膜，該複數個抗硫化被動元件係用以控制並傳導一電流至該複數個揮發性記憶體單元，該保護膜係用以覆蓋該印刷電路板；其中該複數個抗硫化被動元件係包含一抗硫化電阻及一抗硫化排阻，且該抗硫化電阻及該抗硫化排阻彼此間係分離設置。

(2)如申請專利範圍第1 項所述之記憶體儲存裝置，其中該抗硫化電阻之一最佳電阻值為240歐姆。

(3)如申請專利範圍第1 項所述之記憶體儲存裝置，其中該抗硫化電阻之電阻值之誤差值係介於240 歐姆之上下5%區間內。

(4)如申請專利範圍第1 項所述之記憶體儲存裝置，其中該抗硫化電阻之電阻值之誤差值係介於240 歐姆之上下3%區間內。

(5)如申請專利範圍第1 項所述之記憶體儲存裝置，其中該抗硫化電阻之電阻值之誤差值係介於240歐姆之上下1%區間內。

(6)如申請專利範圍第1 項所述之記憶體儲存裝置，其中該抗硫化排阻之一最低電阻值為15歐姆。

(7)如申請專利範圍第1 項所述之記憶體儲存裝置，其中該抗硫

化排阻之一最高電阻值為39歐姆。

(8)如申請專利範圍第1 項所述之記憶體儲存裝置，其中該連接介面單元係為一金手指，且該金手指之厚度介於20至30微米。

(9)如申請專利範圍第1 項所述之記憶體儲存裝置，其中該連接介面單元係為一金手指，且該金手指之厚度介於35至45微米。

(三)舉發證據之說明：

證據1 為2004年06月21日公告之我國第595798號「控制線路連接的多電阻值排阻」專利案（如附圖二所示，見本院卷第75至97頁）；證據2 為2014年10月16日公開之我國第000000000 號「用於保護塗層的遮罩基板」專利案（如附圖三所示，見本院卷第99至144 頁）；證據3 為2014年04月21日公告之我國第M477029 號「排阻之無鉛抗硫化構造」專利案（見本院卷第145 至163 頁，如附圖四所示）。上開證據之公開日均早於系爭專利申請日（2016年5 月24日），可為系爭專利相關之先前技術，此為兩造及參加人所不爭執。

(四)證據1 、2 、3 之組合足以證明系爭專利請求項1 至9 不具進步性：

1.關於系爭專利請求項1：

(1)證據1 是一種電阻排阻裝置，以包含二至多種電阻值，用以配合不同線路設定，而使用相同的電路板組裝。並且提供一種組裝方式，以使用多電阻值排阻作為組裝信號線的連接或切斷裝置。

(2)經比對證據1 與系爭專利請求項1 ，證據1 圖3 及說明書第7 頁第1 至3 行揭示「…記憶體模組的結構圖。記憶體模組

01 301 包含了八個記憶體線路區塊302 。記憶體線路區塊302
02 包含一個記憶體晶片303 和一組電阻器304 。每個電阻器作
03 為一個連結裝置，以連結一個記憶體晶片的資料位元線，到
04 一個記憶體線路區塊的資料位元線。記憶體線路區塊的資料
05 位元線則被連結到記憶體模組的邊緣連結器305 」（見本院
06 卷第81頁），證據1 雖未揭示記憶體晶片為揮發性記憶體抑
07 或是非揮發性記憶體，惟記憶體晶片種類係所屬技術領域之
08 通常知識，且不論是何種記憶體晶片皆須使用電阻或排阻元
09 件作為連接裝置，提供資料訊號傳輸及穩壓作用，於記憶體
10 裝置上並無差異，是以揮發性記憶體的置換，屬通常知識之
11 簡單變更，故證據1 之記憶體晶片、電阻器及邊緣連結器可
12 對應系爭專利請求項1 之複數個揮發性記憶體單元、被動元
13 件及連接介面單元。

14 (3)證據1 第6 頁5 至6 行揭示記憶體模組使用同一種印刷電路
15 板（見本院卷第80頁），可對應系爭專利請求項1 之印刷電
16 路板。證據1 圖1 、圖4 揭示排阻結構圖，包含電阻器102
17 、103 、104 及105 （411 、412 、413 及414 ），圖2 揭
18 示電阻器203 包含兩個排阻204 及205 ，圖5 揭示電阻器組
19 合504 包含四個排阻，每個排阻包含四個電阻器，兩組排阻
20 間分離設置，說明書第5 頁揭示「…為了使該裝置能達到組
21 成的目的，模組板上的電阻器需要有某種組合的電阻值。該
22 裝置固然可以使用六十四或一百二十八個單獨電阻器以配合
23 如此情況，然而組裝程序會比較費時，並且也可能受到模組
24 板上最多元件數目的限制」（見本院卷第79頁），可知習知
25 記憶體裝置使用單獨電阻器達成某種組合的電阻值，系爭專
26 利所屬技術領域中具通常知識者當可思及以電阻及排阻達成

01 所需電阻值，故可對應系爭專利請求項1 之被動元件係包含
02 一電阻及一排阻，且該電阻及該排阻彼此間係分離設置等技
03 術內容。

04 (4)證據1 雖未揭示電阻、排阻為抗硫化電阻、排阻及一保護膜
05 用以覆蓋印刷電路板等技術內容，惟證據3 圖1 及第【0012
06 】段揭示「…於一母版10上製作包含多數具有無鉛抗硫化構
07 造之電阻器單元11、12、13、14、15，而形成排阻電阻器10
08 0」（見本院卷第151 頁），圖2 及第【0018】段揭示「一
09 抗硫層51，係印刷在下部電極31的下表面上，並覆蓋至電阻
10 元件層41和下部電極31的接觸介面，以避免下部電極31因為
11 接觸外在硫化物而變成硫化銀…」（見本院卷第152 頁），
12 可知證據3 之排組電阻器包含多個具有無鉛抗硫化構造之電
13 阻器，而該些具無鉛抗硫化構造之電阻器具有一抗硫層，可
14 避免內部下部電極因接觸外在硫化物變成硫化銀，是證據3
15 已揭示抗硫化電阻、排組之技術特徵。

16 (5)又證據2 圖2A及第【0034】段揭示「…圖2A說明保護塗層20
17 2 已塗覆至的基板100 之一具體實例。保護塗層202 可經組
18 態以保護基板100 免受濕氣（例如，各種形式之水、水性物
19 質、其他液體等）及／或污染。可使用非選擇性且非方向性
20 之製程…來塗覆保護塗層202，從而使曝露之組件被塗佈而
21 不管最終是否需要塗佈基板之每一個組件或特徵。在一個具
22 體實例中，塗覆保護塗層202，使得該保護塗層覆蓋基板10
23 0 之所有曝露之表面，包括基板100 上之任何遮罩106。」
24 （見本院卷第113 頁）可知基板可覆蓋一保護塗層，以防止
25 暴露於濕氣、水性物質或汙染物，是證據2 已揭示保護膜用
26 以覆蓋印刷電路板之技術特徵。

(6)證據1、證據2及證據3同屬電子電路技術領域，具有技術領域之關聯性；證據2記載避免基板上元件受濕氣或汙染物影響、證據3記載避免電阻器元件受硫化氣體影響，皆具對抗環境中不利因子之目的，具所欲解決問題之共通性，且提升記憶體於環境使用壽命是記憶體領域普遍問題，證據1之記憶體勢必會面臨環境中濕氣或硫分子造成元件受潮、硫化之問題，所屬技術領域中具有通常知識者自有動機去參酌證據2之保護塗層及證據3之抗硫化電阻元件，運用至證據1記憶體模組裝置之印刷電路板，以達系爭專利請求項1之發明，且系爭專利僅為結合證據1、2及3技術內容功效之總合，未產生無法預期之功效，則證據1、2、3之組合自足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

2.關於系爭專利請求項2：

系爭專利請求項2依附於請求項1，並更进一步界定「其中該抗硫化電阻之一最佳電阻值為240 歐姆」附屬技術特徵。查證據1第7頁第9行至第8頁第2行揭示「排阻元件401包含電阻器411、412、413和414。電阻器411、412和413為同樣電阻值，例如為十歐姆。劃有暗線的電阻器414為另一電阻值，例如為一百萬歐姆。…本創作中每一個次組裝電阻器的主要功能，在產生邏輯上的連接和切斷的效果。連接的效果，經由一個低電阻值的電阻器產生。一個適當的電阻值為十歐姆，或二十二歐姆。此電阻器可以使用低阻抗的材料製成。當電阻器的電阻值低到一個甚小的數值之下，可以稱為一個零阻值電阻器。當電阻值小到接近於零時，可以認定為一種短路連接，雖然在物理上電阻器的電阻值無法完全等於零。基於同樣理由，在物理上電阻器的電阻值也無法

01 高到無限大。因此切斷的效果，其實是相當於一個高電阻值
02 的電阻器，只要電阻值高到一個適當的數值之上」（見本院
03 卷第81至82頁），已例示說明低電阻電阻值可為零電阻、10
04 歐姆、22歐姆，高電阻電阻值可為一百萬歐姆，其雖未記載
05 最佳電阻值為240 歐姆，惟電阻器主要功能係邏輯上產生連
06 接或切斷之效果，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者
07 經例行性工作或實驗，即可獲得適用於所設計之記憶體晶片
08 外接電阻的最佳化數值，故系爭專利請求項2 之附屬技術特
09 徵實為證據1 電阻值之簡單改變，又證據1 至3 之組合可證
10 明系爭專利請求項1 不具進步性，已如前述，則該組合亦可
11 證明系爭專利請求項2 不具進步性。

12 3.關於系爭專利請求項3至5：

13 系爭專利請求項3 至5 係直接依附於請求項1 ，並更进一步界
14 定「其中該抗硫化電阻之電阻值之誤差值係介於240 歐姆之
15 上下5%區間內」、「其中該抗硫化電阻之電阻值之誤差值係
16 介於240 歐姆之上下3%區間內」、「其中該抗硫化電阻之電
17 阻值之誤差值係介於240 歐姆之上下1%區間內」附屬技術特
18 徵。查電阻具有容許誤差值係為所屬技術領域之通常知識，
19 如證據1 第8 頁第10至11行所揭示「製造排阻的製程中可能
20 產生百分之一至百分之十的誤差值」（見本院卷第82頁），
21 系爭專利所屬技術領域中之通常知識者自可依記憶體規格，
22 選用不同誤差精度之電阻，故證據1 至3 之組合亦可證明系
23 爭專利請求項3 至5 不具進步性。

24 4.關於系爭專利請求項6、7：

25 系爭專利請求項6 、7 分別依附於請求項1 ，並更进一步界定
26 「其中該抗硫化排阻之一最低電阻值為15歐姆」、「其中該

01 抗硫化排阻之一最高電阻值為39歐姆」附屬技術特徵。證據
02 1 至3 雖未揭示排阻之最低電阻值為15歐姆及最高電阻值為
03 39歐姆，惟如前所述，證據1 揭示電阻器主要功能係邏輯上
04 產生連接或切斷之效果，連接之效果係低電阻值之電阻器可
05 達成，排阻於製作過程中可能會產生百分之一至百分之十之
06 誤差值，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者為幫助記
07 憶體穩壓並達成記憶體之連接，即可經例行性工作或實驗，
08 獲得適用於所設計之記憶體晶片之外接排阻的最高、最低電
09 阻值，故證據1 至3 之組合亦足以證明系爭專利請求項6 、
10 7 不具進步性。

11 5.關於系爭專利請求項8、9：

12 系爭專利請求項8、9 依附於請求項1，並更进一步界定「其
13 中該連接介面單元係為一金手指，且該金手指之厚度介於20
14 至30微米」、「其中該連接介面單元係為一金手指，且該金
15 手指之厚度介於35至45微米」附屬技術特徵。查證據1 雖揭
16 示邊緣連結器，而未限定其厚度，惟金手指之厚度，與其使
17 用材質、所插設之插槽及插拔壽命考量有關，不同材質的鍍
18 層厚度有其一般厚度或最大厚度的設計規範，系爭專利所屬
19 技術領域中具有通常知識者為提高連接介面可靠性，自會考
20 量適當之金手指厚度，使其與插槽緊密連結並增加插拔耐久
21 性，厚度之選擇屬通常知識之簡單變更，故證據1 至3 之組
22 合足以證明系爭專利請求項8 至9 不具進步性。

23 6.原告雖稱：證據1 至3 並無結合之動機，事實上記憶體領域
24 最常發生之電阻失效模式為開路、阻值飄移、引線斷裂、短
25 路等4 種問題，最直覺解決方式就是更換電阻，因此通常知
26 識者完全不知硫分子與記憶體模組壽命減少之關聯性，證據

01 1 沒有抗硫化之意識，自無法與證據2、3 結合云云。按判
02 斷該發明所屬技術領域中具通常知識者是否有動機能結合複
03 數引證之技術內容時，係就「技術領域之關連性」、「所欲
04 解決問題之共通性」、「功能及作用之共通性」及「教示或
05 建議」等事項，綜合考量判斷之，查：

06 (1)原告所稱4 種記憶體常見的電阻失效模式，只是電阻失效的
07 表現形式，對於其失效的原因仍須研究後提出改善或建議，
08 而系爭專利說明書第【0003】段記載「由於目前電子裝置的
09 普及化，其設置之地點極有可能是位於戶外之場所，『使得
10 空氣中之化合物或是水分子接觸到記憶體裝置之機率大增，
11 而造成記憶體裝置的壽命減短』。舉例來說，『目前記憶體
12 裝置上的電阻均含有銀之成份，當其與空氣中的硫分子接觸
13 到時，則原有含銀之傳導層將會起化學作用而產生硫化銀，
14 使得此傳導層漸漸成為一絕緣體』，而最後將導致電流無法
15 通過此電阻並使此記憶體裝置無法再被使用。」已說明習知
16 問題乃在於電阻含有銀，銀與空氣中的硫分子接觸會產生硫
17 化銀進而影響電阻效用等語，因此原告主張該發明所屬技術
18 中具通常知識者無法輕易思及硫分子與記憶體模組壽命減少
19 之關聯性云云，顯不足採。

20 (2)再者，判斷舉發證據之技術內容的技術領域是否具關連性，
21 得就應用該技術之物、原理、機制或作用等予以考量。證據
22 1 是一種具電阻排阻之記憶體模組，包含二至多種電阻值，
23 該模組包含記憶體晶片、電阻器與排阻器之使用，配合不同
24 線路設定，而使用同一種印刷電路板組裝（見本院卷第80頁
25 ），證據2 第2A圖與第【0034】段記載保護塗層可經組態以
26 保護基板（印刷電路板）免受濕氣（各種形式之水、水性物

質、其他液體）及／或汙染（見本院卷第113 頁），第【0021】段記載基板可包括一印刷電路板或其他載體及載體上的一個或多個組件，如記憶體器件、電阻器等（見本院卷第109 頁），證據3 記載在PCB 電路板安裝無鉛抗硫化構造之電阻器，防止硫化氣體侵蝕，且晶片型電阻器常被安裝於半導體模組上（見本院卷第155 、149 頁），由上可知，證據1 揭示習知記憶體模組具有印刷電路阻，證據2 、3 分別為印刷電路板之防潮塗層及電阻之抗硫化結構，可廣泛應用於各印刷電路板及電子產品之解決方案，亦與記憶體模組之基本構件相關，三者應用該技術之物具關連性，自屬記憶體模組領域相關技術者所會合理接觸及參考之文件。

(3)此外，判斷複數引證間所欲解決之問題是否具有共通性，並非僅以引證中所記載之所欲解決問題來認定，尚需考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者能易於思及之所欲解決問題來判斷。證據1 說明書記載所欲解決之問題雖在於簡化電子線路模組製造程序，然證據3 第【0007】段、第【0017】段、第【0033】段揭示電阻元件層係使用不含鉛之鎳鉻合金或鎳銅合金材質經濺鍍製程或蒸鍍製程所形成，設在基板的下表面，而能確實防止外在硫化氣體的侵蝕，能有效改善習見電阻器之缺失（見本院卷第150 、152 、155 頁），證據2 第【0002】段揭示電子器件之耐久性對消費者而言常為關心之問題，且提出避免不利影響電子器件，又可防止電子器件暴露於濕氣及汙染之保護塗層，是提升電子器件於環境使用壽命及可靠度為各電子器件領域普遍問題（見本院卷第105 頁），顯見硫化為造成習知電阻器失效的原因之一，證據1 揭示之電阻、排阻為電子裝置上的元件，所屬技術領域中

通常知識者當然可輕易思及證據1 會面臨相同之問題。而證據1 為一般記憶體模組構件，無法對抗環境中濕氣或硫分子，具壽命減短的問題，證據2 面臨環境中濕氣之問題，提供保護塗層以防止基板上組件曝露於濕氣或汙染，證據3 面臨電阻之下部電極因接觸環境中硫化氣體（汙染）而遭侵蝕，提供一抗硫層覆蓋電阻元件層和下部電極的接觸表面，該所屬技術領域具有通常知識者在證據1 之記憶體裝置技術基礎上，面臨空氣中之硫分子或水分子接觸到記憶體裝置造成記憶體裝置之壽命減短之問題時，基於改善記憶體裝置壽命之需要，自有合理的動機將證據2 及證據3 之技術內容運用於證據1 之電阻元件及印刷電路板，將證據1 之電阻元件置換為抗硫化結構電阻並以保護塗層覆蓋印刷電路板，以解決受潮及硫化問題，是證據1 至3 在所欲解決之問題、功能、作用上均有共通性存在，自有組合動機，原告上開主張，並不足採。

7.原告又主張：證據1 至證據3 並未記載系爭專利請求項2 至7 之電阻值，況證據1 目的在使不良品能夠被組合成可用的模組製品以及簡化電子線路模組的製造程序，自無動機去實驗或嘗試變化為不同的特定電阻值云云。惟依系爭專利所載，增加記憶體於環境之使用壽命，應在於電阻之結構改良為抗硫化結構，且系爭專利說明書並未記載係使用於工控領域之記憶體，亦未說明電阻值如何助於增加記憶體之使用壽命；證據1 僅為提供一種簡化電子線路模組的製造程序，並未限制通常知識者改變特定電阻值，或改變特定電阻值會使證據1 無法實施，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者當能經例行性工作或實驗，獲得適用於自身所設計之記憶體晶

片外接電阻的最佳化數值、不同誤差精度之電阻範圍，及外接排阻之最高、最低電阻值，故原告主張尚不足採。

8.原告又稱：其推出抗硫化產品後，記憶體の出貨數量即大幅提升，他廠相似產品接連推出，故系爭專利「具有無法預期之功效」、「解決長期存在的問題」以及「獲得商業上成功」等肯定進步性之輔助性判斷因素云云。惟查：

(1)判斷是否為「長期存在的問題」，必須同時符合下列三個要件：①該問題為申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者公認為長期存在的問題，②該問題於申請專利之發明申請前始終未被解決，③申請專利之發明能成功解決該問題。原告稱記憶體儲存裝置長久以來被忽略且長期存在而無法解決之問題，即系爭專利「先前技術」所記載之「目前記憶體裝置上的電阻均含有銀之成份，當其與空氣中的硫分子接觸到時，則原有含銀之傳導層將會起化學作用而產生硫化銀，…」，然證據3 的排阻之無鉛抗硫化構造，已經在系爭專利申請前提供解決方案，且將記憶體使用抗硫化電阻及保護膜達到抗硫化、防潮及增加壽命之效果，對系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言，係於發明申請時可預期，是其主張系爭專利具有「無法預期之功效」、「發明解決長期存在的問題」云云，並不足採。

(2)再者，判斷發明是否具商業上成功之肯定進步性因素，必須其成功是由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成。依原告所提甲證4、甲證5 記憶體銷售額（見本院卷第219 至227 頁），細譯其內容，各記憶體在導入抗硫化（型號標示Anti-Sulfuration者）之後，並非所有記憶體の出貨數量都全部上升，有的型號出貨

數量反而下降（如DDR3 SODIMM 00000-00 000x8 4GB HYN
1.35V（AQD）G），又有的型號在導入抗硫化後雖然出貨
數量上升，但各型號抗硫化記憶體於2018年11月至2019年10
月間之平均單價皆較2017年11月至2018年10月間非抗硫化記
憶體之平均單價為低，則出貨數量上升之型號究竟是因為單
價降低所致，還是因為引進抗硫化所致，無法得知，此外，
原告亦未提出其他證據佐證實施系爭專利之商品銷售量高於
同性質之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品，則依原
告所舉證據，實無法證明系爭專利是因其發明之技術特徵而
非技術以外之銷售策略導致商業上成功，自無法為有利原告
之認定。

(3) 本件無法認定系爭專利具有上開肯定進步性之輔助性判斷因
素存在，是原告據此主張系爭專利具進步性，亦無理由。

六、綜上所述，證據1、2、3之組合，可證明系爭專利請求項
1至9不具進步性，而違反核准時專利法第22條第2項規定
，從而，被告所為「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之
處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請
撤銷訴願決定及原處分上開舉發成立部分，為無理由，應予
駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結
果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第
1條，行政訴訟法第218條、第98條第1項前段，民事訴訟法第
385條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 109 年 11 月 30 日

智慧財產法院第一庭

審判長法官 李維心

法官 陳忠行

法官 蔡如琪

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。

行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人

- 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。
- 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
- 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。

是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。

中 華 民 國 109 年 12 月 10 日
書記官 邱于婷